
	<p><b>SI4102DY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4102DY-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4102DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12105 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4102DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12105 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 4.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	158 mOhm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	370pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














SI4102DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4102DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4102DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4102DY-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4102DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>Si4102DY</b> VISHAY SI4102DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4104DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4103DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V SO-8</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI4101DY-T1-GE3	 SI4101DY-T1-GE3	 SI4012-C1001GTR	 SI4021-A1-FTR	 SI4022-A0-FTR
 SI4022-A1-FTR	 SI4030-A0-FM	 SI4032-V2-FMR	 SI4033-B2-FM	 SI4048DY-T1-E3
 SI4056DY	 SI4056DY-T1-E3	 SI4056SPG	 SI4058DY	 SI4090DY
 SI4100BDDY-T1-GE3	 SI4100DY	 SI4100DY-T1-E3	 SI4100DY-T1-E3	 SI4100DY-T1-GE3
 SI4100DY-T1-GE3	 SI4102DY	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-GE3
 SI4104DY-T1-GE3	 SI4104DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4110DY-T1-GE3
 SI4110DY-T1-GE3	 SI4112-D-GM	 SI4113-BMR	 SI4114DY	 SI4114DY-T1-E3
 SI4114DY-T1-E3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4116DY	 SI4116DY-T1-E3
 SI4116DY-T1-E3	 SI4116DY-T1-GE3	 SI4116DY-T1-GE3	 SI4122-BTR	 SI4122-D-GMR
 SI4122DY-T1-E3	 SI4122G-BMR	 SI4123-BM	 SI4124DY-T1-E3	 SI4124DY-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited